



Title of Change:	NCV7428 Datasheet Update										
Effective date:	20 September 2018										
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <roman.buzas@onsemi.com>										
Type of notification:	This Product Bulletin is for notification purposes only. ON Semiconductor will proceed with implementation of this change upon publication of this Product Bulletin.										
Change Category:	☐ Wafer Fab Change ☐ Assembly Change ☐ Test Change ☒ Other <u>Datasheet</u>										
Change Sub-Category(s):	☐ Manufacturing Site Addition ☐ Material Change ☒ Datasheet/Product Doc change ☐ Manufacturing Site Transfer ☐ Product specific change ☐ Shipping/Packaging/Marking ☐ Manufacturing Process Change ☐ Other: _____										
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: None	External Foundry/Subcon Sites: None									
Description and Purpose: Update of the Current Consumption and LIN Transmitter parameters. Current Consumption: - Standby mode: Max value $I_{VS_LIN_Wakeup}$ from 40μA to 33μA - Sleep mode: Max value I_{VS_Sleep} from 25μA to 18μA LIN Transmitter: - TXD dominant timeout: Min value $t_{TXD_timeout}$ from 7ms to 9ms. Limits are narrowing which is favourable for the customer. These change will not impact form, fit, or function of products.											
List of Affected Parts: <table> <tr> <td>NCV7428D13R2G</td> <td>NCV7428D1L3R2G</td> <td>NCV7428MW3R2G</td> <td>NCV7428MWL3R2G</td> </tr> <tr> <td>NCV7428D15R2G</td> <td>NCV7428D1L5R2G</td> <td>NCV7428MW5R2G</td> <td>NCV7428MWL5R2G</td> </tr> </table>				NCV7428D13R2G	NCV7428D1L3R2G	NCV7428MW3R2G	NCV7428MWL3R2G	NCV7428D15R2G	NCV7428D1L5R2G	NCV7428MW5R2G	NCV7428MWL5R2G
NCV7428D13R2G	NCV7428D1L3R2G	NCV7428MW3R2G	NCV7428MWL3R2G								
NCV7428D15R2G	NCV7428D1L5R2G	NCV7428MW5R2G	NCV7428MWL5R2G								

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



変更件名:	NCV7428 データシート更新										
発効日:	20 September 2018										
連絡先情報:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または <roman.buzas@onsemi.com> にお問い合わせください。										
通知種別:	本製品速報は通知目的のみです。オン・セミコンダクターは本製品速報の発行により本変更を実行します。										
変更カテゴリ:	☐ ウェハファブの変更 ☐ アセンブリの変更 ☐ 試験の変更 ☒ その他 データシート										
変更サブカテゴリ:	☐ 製造拠点の追加 ☐ 材料の変更 ☒ データシート/製品資料の変更 ☐ 製造拠点の移転 ☐ 製品仕様の変更 ☐ 出荷/パッケージング/表記 ☐ 製造プロセスの変更 ☐ その他										
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: なし	外部製造工場または下請け業者拠点: なし									
説明および目的: 電流消費および LIN トランスミッター パラメータの更新 電流消費: - スタンバイモード: 最大値 $I_{VS_LIN_ウエイクアップ}$ を $40\mu A$ から $33\mu A$ へ変更 - スリープモード: 最大値 $I_{VS_スリープ}$ を $25\mu A$ から $18\mu A$ へ変更 LIN トランスミッター: - TXD ドミナントタイムアウト: 最小値 $t_{TXD_タイムアウト}$ を $7ms$ から $9ms$ へ変更 リミットはお客様にとって有利に制限されています。 これらの変更は製品の形状、適合性、または機能に影響を及ぼしません。											
影響を受ける部品の一覧: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>NCV7428D13R2G</td><td>NCV7428D1L3R2G</td><td>NCV7428MW3R2G</td><td>NCV7428MWL3R2G</td></tr> <tr> <td>NCV7428D15R2G</td><td>NCV7428D1L5R2G</td><td>NCV7428MW5R2G</td><td>NCV7428MWL5R2G</td></tr> </table>				NCV7428D13R2G	NCV7428D1L3R2G	NCV7428MW3R2G	NCV7428MWL3R2G	NCV7428D15R2G	NCV7428D1L5R2G	NCV7428MW5R2G	NCV7428MWL5R2G
NCV7428D13R2G	NCV7428D1L3R2G	NCV7428MW3R2G	NCV7428MWL3R2G								
NCV7428D15R2G	NCV7428D1L5R2G	NCV7428MW5R2G	NCV7428MWL5R2G								